

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点 利用規程  
(ARIM 加工・デバイスプロセス分野／物質・材料合成プロセス分野)

<趣旨>

第1条 この規程は、大阪大学内に設置されたマテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（以下、「当拠点」という。）における ARIM 加工・デバイスプロセス分野及び ARIM 物質・材料合成プロセス分野の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

<目的>

第2条 当拠点が設置供用する装置及び実験室等（以下、「装置群等」という。）のうち、別表に定める ARIM 加工・デバイスプロセス分野管理の装置群及び ARIM 物質・材料合成プロセス分野管理の装置群について、ナノテクノロジー・ナノサイエンスを基盤とする最先端の研究・開発に挑む学内外の利用者（産学官の研究者）に対して、高度な技術支援を行うとともに、利用機会を提供する。

2 別表の装置群等については、適宜変更することがある。

<利用日>

第3条 装置群等の利用日は、次の各号に掲げる以外の日とする。

- (1) 日曜日及び土曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
- (3) 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、拠点長（大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点設置要項第4条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。）が特に必要と認めたときは、臨時に利用させ、又は利用を中止させることがある。

<利用時間>

第4条 装置群等の利用時間は、午前9時00分から午後5時00分とする。

2 前項の規定にかかわらず、拠点長が特に必要と認めたときは、その時間を延長し、又は短縮することがある。

<利用者の資格>

第5条 装置群等を利用することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

- (1) 本学の教職員及び学生
- (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
- (3) 企業等の法人に所属し、研究開発に従事する者
- (4) その他、拠点長が特に必要と認めた者

<利用の申請>

第6条 装置群等を利用しようとする者（以下、「申請者」という。）は、所定の申請書を拠点事務室（大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点設置要項第6条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。）に提出し、管理運営委員会（大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点設置要項第5条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。）にてその承認を受けなければならない。

2 拠点長は、前項により承認された申請者に対し利用を許可し、その旨を次の各号に掲げる事項と共に30日以内に通知するものとする。

- (1) 申請者
- (2) 第6項の規定に基づき指定された利用責任者
- (3) 課題名
- (4) 課題番号
- (5) 第8条第2項の規定に基づき適用される利用形態
- (6) 利用期間
- (7) 第4項の規定に基づき拠点長が付す条件
- (8) その他拠点長が指定する事項

3 申請者が前項の許可と共に通知された前項各号（第4号を除く）の内容を変更しようとするときは、拠点長の許可を受けなければならない。

4 拠点長は、第2項の許可に際し必要と認めるときは、当該利用について必要な条件を付すものとする。

5 第2項における許可を受けられなかった申請者は、その異議を申し立てることはできない。また、許可を受けられなかったことによる不利益に対して、当拠点は責を負わない。

6 第2項の許可を受けた申請者は、装置群等の利用に関する責任者（以下「利用責任者」という。）となる。

7 第2項の許可を受けた申請者は、前項の規定にかかわらず利用責任者を別に指定することができる。指定された者は次条以降本規程において申請者に代わり第6項に規定する利用責任者とする。

#### <利用の取り下げ>

第6条の2 前条2項にて許可された申請者が当拠点の利用を必要としなくなった場合は、拠点長に対し当該利用の取り下げを申請し、承認を得なければならない。

2 前項の取り下げについて利用開始後は申請できない。

#### <利用の区分>

第7条 装置群等の利用区分として、委託区分と自主区分とを設け、次の各号の一に該当する区分を自主区分とする。

- (1) 当拠点の運営関係者の利用の場合
- (2) その他、管理運営委員会が特に必要と認めた場合

＜利用の形態＞

第8条 装置群等の利用形態として、次の各号を設ける。

- (1) 機器利用
- (2) 技術相談
- (3) 技術補助
- (4) 技術代行
- (5) 共同利用 / 協力研究
- (6) データ利用

2 前項に掲げる利用形態は許可された1の課題に対して複数適用することができる。

＜利用責任者の責務＞

第9条 利用責任者は、装置群等の利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に利用しなければならない。

- (1) 利用を許可された装置群等および安全衛生に関する事項について、拠点長が定める装置管理者等による十分な教育を受けること。
- (2) 利用を許可された装置群等及び設備、備品等の保全に努めること。
- (3) 利用を許可された目的以外に使用しないこと。
- (4) 利用を許可された装置群等及び設備、備品等を他の者に一部又は全部を転貸しないこと。
- (5) 利用を許可された装置群等及び設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、拠点長が許可する場合を除く。
- (6) その他拠点長が定め、又は指示する事項

2 前項については、第6条第1項で提出する申請書に記載された装置群等の利用にかかる関係者（以下「共同利用者」という。）にも適用する。

＜利用の許可の取消等＞

第10条 拠点長は、次の各号の一に該当する場合、装置群等の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

- (1) 利用責任者および共同利用者が、この内規に違反し、又は違反するおそれがあると拠点長が認めるとき
- (2) 申請者が、所定の申請書に虚偽の記載をしたとき
- (3) 本学において、管理上の事由が生じたとき
- (4) 申請者若しくは利用責任者が、死亡若しくは連絡がつかないとき
- (5) 申請者若しくは利用責任者の所属する法人が、解散もしくは清算されたとき

2 前項の適用によって利用の許可を取り消し、又は利用の中止を受けた場合にあっては、第11条、第14条、第15条、第17条、第18条については当該問題の解決に至るまで適用する。また第12条に基づく債務がある場合は履行しなければならない。

#### <報告義務>

第11条 利用責任者は、拠点長からその利用にかかる事項について報告を求められた場合は、それに応じなければならない。

#### <利用負担金等>

第12条 利用責任者は、本学の指定する方法により、利用負担金を納付しなければならない。

2 利用負担金の額は別規程に定めるところによる。

3 秘密保持契約の締結を要する技術相談に関しては、5,000円／時間を上限とする。

4 一旦納付された利用負担金は、返還しない。ただし、本学の都合により利用の許可を取り消し又は利用を中止した場合は、利用負担金の全部又は一部を返還する。

#### <消耗品等>

第13条 装置群等で使用する消耗品及び材料等は原則として利用責任者が準備し、負担するものとする。

2 当拠点にある消耗品及び材料等を使用した場合は、その実費を負担するものとする。

3 利用責任者が準備し、負担する材料については、本学の諸規程（拠点長が定める利用の手引きを含む）に従い拠点長が使用を認めたもののみとする。

#### <損害賠償>

第14条 利用責任者又は共同利用者がその責に帰すべき事由により装置群等及び設備又は物品を滅失、破損または汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

#### <原状回復>

第15条 利用責任者又は共同利用者が当該装置群等の利用を終えたとき（第10条の規定により利用許可の取り消し、又は利用を中止した場合を含む。）は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、拠点長が特に認めたときは、この限りではない。

2 利用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、拠点長は利用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合利用責任者は、拠点長に異議を申し立てることができない。

#### <装置群等利用の明記>

第16条 利用責任者及び共同利用者は、当拠点を利用して行った研究成果を論文、学会発表、特許等（以下、「当該成果物」という。）により公表するときは当該成果物の謝辞等に次の各号のうちいずれか1つ掲げる文を明記するものとする。

(1) 和文：本研究（の一部）は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業（課題番号：JPMXP12yyOSxxxx）の支援を受けて、大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点において実施されました。

(2) 英文 : (A part of) This work was supported by “Nanotechnology Platform Project (Nanotechnology Open Facilities in Osaka University)” of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT) [Grant No.: JPMXP12yyOSxxxx].

2 前項にある次に掲げる文については、掲載の都合上簡略した表記にしても差し支えない。ただし課題番号については略することができない。

3 当該成果物に対して複数与えられていた場合はその全ての課題番号を記載しなければならない。

4 課題番号は第6条第2項第4号に基づき拠点長が通知する。

#### <安全衛生管理>

第17条 利用責任者及び共同利用者は、当該拠点における安全衛生管理について、関係する法令及び本学の諸規程（拠点長が定める利用の手引きを含む。以下「法令等」という。）を遵守するとともに、法令等に基づき拠点長が行う指示に従わなければならない。

2 利用責任者及び共同利用者は、騒音、振動、水質汚濁及び悪臭等の環境問題が発生しないよう、予防措置を講ずるものとし、問題が発生した場合は、利用責任者の責任において速やかに解決のための措置を講じなければならない。

3 前項の問題が解決されない場合は、拠点長は、装置群等の利用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

4 利用責任者は、マテリアル先端リサーチインフラ事業運営に影響を及ぼすものと拠点長が判断する重大な事故等が発生した場合に、拠点長が文部科学省およびマテリアル先端リサーチインフラ関係機関へ、その旨報告することに同意するものとする。なお、利用責任者及び共同利用者は、拠点長が行う報告書の作成に協力しなければならない。

5 利用責任者及び共同利用者は当拠点の利用にあたり、拠点長が指定する方法により第1項に定める内容を遵守する旨の誓約書を提出する。ただし、利用責任者及び共同利用者のうち、当拠点の施設に立ち入らない者からの提出を要しない。

#### <不正行為の防止>

第18条 利用責任者及び共同利用者は、不正行為を行ってはならない。また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

2 前項の「不正行為」の定義は「大阪大学における公正な研究活動の推進に関する規程」における定義を準用する。

3 利用責任者及び共同利用者は、拠点長が指定する方法により第1項に定める内容を遵守する旨の確認書を提出する。

#### <その他>

第19条 この内規に定めるもののほか、装置群等の利用に関し必要な事項は、拠点長が別途定める。

附 則

この利用規程は、令和４年５月９日から施行し、令和４年４月１日から適用する。  
旧「大阪大学 ナノテクノロジー設備供用拠点利用規程」は廃止する。

附 則

この改正は、令和６年８月１日から施行する。

附則

この改正は、令和７年３月１７日から施行する。

別表

| 装置群                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 高精細集束イオンビーム装置</li><li>● SEM 付集束イオンビーム装置</li><li>● 超高精細電子ビームリソグラフィー装置</li><li>● 自動搬送電子ビーム描画装置</li><li>● 高速大面積電子ビームリソグラフィー装置</li><li>● マスクアライナー</li><li>● ナノインプリント装置</li><li>● 深掘りエッチング装置</li><li>● リアクティブイオンエッチング装置（RIE-10NR-NP, RIE-10NOU）</li><li>● 多元 DC/RF スパッタ装置</li><li>● RF スパッタ成膜装置（金属成膜用）</li><li>● RF スパッタ成膜装置（絶縁体成膜用）</li><li>● EB 蒸着装置</li><li>● 薄膜 X 線回折装置</li><li>● ナノ粒子解析装置（ゼーターサイザー）</li><li>● 走査型プローブ顕微鏡</li><li>● 接触式膜厚測定器</li><li>● レーザーラマン顕微鏡</li><li>● 物理特性測定装置</li></ul> |